



10.10.2014 – 11:41 Uhr

Samsung Electronics startet Massenproduktion des industrieweit ersten 3bit 3D V-NAND Flash-Memory

Korea (ots) -

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter
<http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs> -

Samsung Electronics Co. Ltd., Marktführer bei innovativer Speichertechnologie, hat mit der Massenproduktion des branchenweit ersten 3bit Multi-Level-Cell (MLC) dreidimensionalen (3D) Vertical NAND (V-NAND) Flash-Memory für den Einsatz in Halbleiterlaufwerken (SSDs oder Solid State Drives) begonnen.

"Mit der Erweiterung einer völlig neuen Serie an High-Density SSDs, die sowohl hinsichtlich Leistungsfähigkeit als auch im Hinblick der Nutzung des 3bit V-NAND bei Medien zur Datenspeicherung den Übergang von herkömmlichen Festplatten auf SSDs beschleunigen wird", sagt Jaesoo Han, Senior Vice President, Memory Sales & Marketing, Samsung Electronics. "Die größere Vielfalt von SSDs wird unsere Produktwettbewerbsfähigkeit erhöhen, während wir unser schnell wachsendes SSD-Geschäft erneut erweitern."

Das 3bit V-NAND ist Samsungs V-NAND Komponente der zweiten Generation. Genutzt werden 32 vertikal gestapelte Zell-Layer pro NAND Memory Chip. Jeder Chip bietet eine Speicherkapazität von 128 gigabit (Gb).

Bei Samsungs V-NAND Chip-Struktur ist jede Zelle mit Charge Trap Flash (CTF) Technologie elektrisch mit einer nicht-leitenden Schicht verbunden. Jedes Zellenarray ist vertikal auf das nächste Array gestapelt, um Chips mit mehreren Milliarden Zellen zu erhalten.

Der Einsatz von 3 bit-per-cell, 32 Layer, vertikal gestapelter Zellenarrays erhöht die Effizienz der Speicherproduktion enorm. Gegenüber Samsungs 10 nanometer (nm) Class* 3bit planar NAND-Flash ermöglicht das neue 3bit V-NAND mehr als die doppelte Wafer-Produktivität.

Samsung hat sein V-NAND (24 Layer Zellen) der ersten Generation im August 2013 vorgestellt. Seine V-NAND (32 Layer) Zellenarray-Struktur der zweiten Generation stellte das Unternehmen im Mai 2014 vor. Mit der Markteinführung von 32 Layer, 3bit V-NAND diesen Monat ist Samsung im Bereich 3D Memory führend und verleiht der Entwicklung von V-NAND Produktionstechnologie neue Dynamik.

Nachdem 2012 erstmals SSDs auf der Basis von 3bit planar NAND Flash produziert wurden, hat Samsung bewiesen, dass es tatsächlich einen Massenmarkt für High-Density 3bit NAND SSDs gibt.

Das industrieweit erste 3bit 3D V-NAND wird die Marktakzeptanz von V-NAND Memory für SSDs, die sich für normale PC-Anwender eignen, beachtlich vergrößern. Außerdem werden die Speicheranforderungen der meisten Server hinsichtlich "High-Endurance" effizient adressiert.

Über Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie, die Menschen überall neue Möglichkeiten eröffnet. Durch kontinuierliche Innovation und Marktbeobachtung transformiert das Unternehmen die Welten der Fernsehgeräte, Smartphones, Tablets, PCs, Kameras, Haushaltsgeräte, Drucker, LTE-Systeme, Medizingeräte, Halbleiter und LED-Lösungen. Bei Samsung Electronics Co. Ltd. sind 286000 Menschen in 80 Ländern beschäftigt. Der jährliche Umsatz des Unternehmens beträgt über US\$216,7 Mrd. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com.

Über Samsung Semiconductor Europe

Samsung Semiconductor Europe, eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. Seoul, Korea, mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt/Main unterhält Büros in ganz Europa und in der Region EMEA (Middle East & Africa). Der europäische Hauptsitz ist für die Marketing- und Verkaufsaktivitäten der Component Business Units von Samsung Electronics zuständig. Dazu gehören die Bereiche Memory, System LSI, LED und Display Business in EMEA. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com/semiconductor.

* Hinweis für Redakteure: 10 nanometer-Class bedeutet eine Prozesstechnologie mit Halbleiterstrukturen zwischen 10 und 20 Nanometer.

Samsung und das stilisierte Samsung Design sind Warenzeichen und Servicebezeichnungen von Samsung Electronics Co. Ltd. andere Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Kontakt:

Ujeong Jahnke
Samsung Semiconductor Europe GmbH

Tel. +49(0)6196-66-3300, Fax +49(0)6196-66-23525
Email: ujeong.j@samsung.com

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100017914/100762742> abgerufen werden.